JAEA-Research 2008-076



イッテルビウム、ルテチウム、サマリウムの 対称電荷移行断面積

Symmetric Charge Transfer Cross Section of Ytterbium, Lutetium and Samarium

柴田 猛順 田村 浩司 小倉 浩一

Takemasa SHIBATA, Koji TAMURA and Koichi OGURA

先端基礎研究センター

Advanced Science Research Center

KPSC

October 2008

Japan Atomic Energy Agency

日本原子力研究開発機構

本レポートは独立行政法人日本原子力研究開発機構が不定期に発行する成果報告書です。 本レポートの入手並びに著作権利用に関するお問い合わせは、下記あてにお問い合わせ下さい。 なお、本レポートの全文は日本原子力研究開発機構ホームページ(<u>http://www.jaea.go.jp</u>) より発信されています。

独立行政法人日本原子力研究開発機構 研究技術情報部 研究技術情報課
 〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地4
 電話 029-282-6387, Fax 029-282-5920, E-mail:ird-support@jaea.go.jp

This report is issued irregularly by Japan Atomic Energy Agency Inquiries about availability and/or copyright of this report should be addressed to Intellectual Resources Section, Intellectual Resources Department, Japan Atomic Energy Agency 2-4 Shirakata Shirane, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken 319-1195 Japan

Tel +81-29-282-6387, Fax +81-29-282-5920, E-mail:ird-support@jaea.go.jp

© Japan Atomic Energy Agency, 2008

JAEA-Research 2008-076

イッテルビウム、ルテチウム、サマリウムの対称電荷移行断面積

日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター

柴田 猛順、田村 浩司+、小倉 浩一+

(2008年7月14日受理)

ランタノイド元素のうち、イッテルビウム、ルテチウム、サマリウムの対称電荷移行断面積を 計算した。ランタノイド原子・イオン間の電荷移行反応は多くの場合、電荷移行する 6 s 電子の 内側に閉殻でない 4 f n 電子等があるため、共鳴電荷移行だけでなく非共鳴電荷移行の反応経路が ある。低エネルギーでは共鳴移行反応のみ起こり、電荷移行断面積が小さい。ここで取り上げた イッテルビウム、ルテチウム、サマリウムは多くのランタノイド元素とは異なり、共鳴電荷移行 のみが進行する。イッテルビウムは原子が 4f¹⁴6s²、イオンが 4f¹⁴6s で 4f¹⁴が閉殻なので共鳴電荷 移行となる。ルテチウムは原子が 4f¹⁴5d6s²、イオンが 4f¹⁴6s²で、電荷移行では 5 d 電子が移行す る。他の 4f¹⁴、6s²はいずれも閉殻のため共鳴電荷移行のみ進行する。サマリウムは原子が 4f⁶6s²、 イオンが 4f⁶6s で、原子の基底状態は F₀で J=0 のため、原子とイオンが基底状態同士の電荷移 行は共鳴電荷移行反応のみになる。電荷移行断面積のエネルギー依存性はいずれについても単調 減少である。イッテルビウム、サマリウムの断面積は衝突エネルギーが 1eV/amu で、それぞれ、 203Å²、224Å²で、ジスプロシウム等の多くのランタノイド元素の電荷移行断面積より大きい。 一方、ルテチウムでは d 電子が移行するため電荷移行断面積は衝突エネルギーが 1eV/amu で 65Å²と小さい。

原子力科学研究所(駐在):〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根 2-4 + 量子ビーム応用研究部門光量子科学研究ユニット Symmetric Charge Transfer Cross Section of Ytterbium, Lutetium and Samarium

Takemasa SHIBATA, Koji TAMURA⁺ and Koichi OGURA⁺

Advanced Science Research Center Japan Atomic Energy Agency Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken

(Received July 14, 2008)

Cross sections of symmetric charge transfer are calculated for Yb⁺ + Yb, Lu⁺ + Lu and Sm⁺ + Sm. Symmetric charge transfer of lanthanoid elements in most cases has two main reaction paths which are resonant and non-resonant paths due to open 4f shell inside 6s electrons. At low impact energy, charge transfer cross sections are small because only resonant path is possible. On the other hand, the charge transfer of ytterbium and lutetium has only resonant path because ytterbium and lutetium atoms have closed $4f^{14}$ shells. Samarium atom has $4f^6$ electrons and total angular momentum of the ground state is 0. Therefore charge transfer of samarium has also only resonant path. The charge transfer cross sections of these atoms decrease monotonically with the increase of impact energy. The cross sections of ytterbium and samarium are 203 Å² and 224 Å² at the impact energy of 1eV/amu, respectively. These values are larger than the cross sections of many lantanoid elements such as dysprosium. The cross section of lutetium is 65 Å^2 at the impact energy of 1eV/amu. This value is small due to d-electron transfer.

Keywords: Charge Transfer, Cross Section, Ytterbium, Lutetium, Samarium, Lanthanoid Elememts

⁺Advanced Photon Research Unit, Quantum Beam Science Directorate

目 次

1.	はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2.	イッテルビウムの電荷移行断面積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3.	ルテチウムの電荷移行断面積・・・・・3
4.	サマリウムの電荷移行断面積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
5.	考察
6.	まとめ・・・・・ 6
参考	文献・・・・・・7
付録	ジスプロシウムの電荷移行断面積

Contents

1.	$Introduction \cdots \cdots 1$
2.	Charge Transfer Cross Section of Ytterbium ······ 1
3.	Charge Transfer Cross Section of Lutetium ······ 3
4.	Charge Transfer Cross Section of Samarium ······ 4
5.	Discussion ····· 6
6.	Conclusion ····· 6
Refe	erences ······7

Appendix Charge Transfer Cross Section of Dysprosium · · · · · · 12

This is a blank page.

1. はじめに

電荷移行反応¹⁾は反応断面積が大きいのでプラズマプロセスを利用する多くの分野で重要な素 過程である。同種原子・イオン間の対称電荷移行反応は衝突エネルギーが小さくても大きい断面 積をもつので特に重要である。筆者等^{2~7)}は原子法レーザー同位体分離の研究開発の中で、電荷 移行反応による目的同位体イオン減少の評価のため、原子法レーザー同位体分離の対象となるウ ランやランタノイド元素のガドリニウム、ネオジム、セリウム、ジスプロシウムの対称電荷移行 反応断面積の測定を行い、これらの遷移金属の電荷移行断面積がこれまで考えられてきたものよ り小さいことを示してきた。そして対称電荷移行反応がよく研究されてきたアルカリ金属、アル カリ土類金属と比較し遷移金属の電荷移行断面積が小さいことを次のように考えて説明してきた ^{8~10)}。アルカリ金属原子ーイオン間の電荷移行反応では閉殻構造の外側にある1個のs電子が 移行する。移行電子のスピンの向きはどちらでも移行でき、生成する原子もイオンも基底状態で あり、電荷移行でエネルギー変化がない共鳴電荷移行である。カルシウム、バリウム等のアルカ リ土類金属や水銀は、閉殻構造の外側に原子は2個のs電子、イオンは1個のs電子があり、電 荷移行時には、原子の2個のs電子のうちイオンのs電子とはスピンの向きが異なるs電子が移 行できる。電荷移行で原子より s 電子が抜けてできるイオンはスピンの向きによらず基底状態の ²Sであり、この場合も共鳴電荷移行である。これに対し、遷移金属の一例として図1に電子配 置が 4f⁴s²のネオジムの電荷移行反応を示す。このとき原子からs電子が抜けてできるイオン はその内部が閉殻構造でなくその角運動量 J₁が0でないため生成イオンの角運動量は J₁+1/2 または $J_1 - 1/2$ のいずれかになる。 $J_1 + 1/2$ または $J_1 - 1/2$ の状態のどちらか基底状態でこのと き共鳴電荷移行で他方は非共鳴電荷移行になる。ネオジムの場合 J₁-1/2 の 7/2 が基底状態、J₁ +1/2の9/2が励起状態である。衝突エネルギーが十分高い時は、非共鳴経路も近共鳴となり反 応が進行するが、数100eV以下の低エネルギーでは共鳴電荷移行反応のみ進行し断面積が小さく なっている。

さらに、他のランタノイド元素の対称電荷移行反応を考察したところ、多くの元素については ネオジムと同様に共鳴電荷移行と非共鳴電荷移行の反応経路をもつが、イッテルビウム、ルテチ ウム、サマリウムは、それぞれ次のようになって共鳴電荷移行反応のみが起こる。

(1) イッテルビウム:原子が4f¹⁴6s²、イオンが4f¹⁴6s で4f¹⁴が閉殻である。このため移行する 電子のs電子の向きによらず共鳴電荷移行となり、アルカリ土類金属と同じである。

- (2) ルテチウム: 原子が 4f¹⁴5d6s²、イオンが 4f¹⁴6s²で、電荷移行では 5 d 電子が移行する。4f¹⁴、 6s²はいずれも閉殻のため共鳴電荷移行のみ進行する。
- (3) サマリウム:原子が4f⁶6s²、イオンが4f⁶6sである。原子の基底状態は⁷F₀でL=3、S=3、J
 =0で原子、イオンが基底状態同士の電荷移行は共鳴電荷移行反応のみになる。

ここでは、イッテルビウム、ルテチウム、サマリウムの対称電荷移行反応の反応経路を考察し、 その断面積を求めてみた。また、イッテルビウム、ルテチウム、サマリウムと他の多くのランタ ノイドと比較のため、付録にジスプロシウムの対称電荷移行断面積の計算結果も示した。

2. イッテルビウムの電荷移行断面積

イッテルビウムは原子が 4f¹⁴6s²、イオンが 4f¹⁴6s で 4f¹⁴が閉殻である。このためイッテルビウ

ムの電荷移行は

 $Yb(4f^{14}6s^2, {}^{1}S_0) + Yb^+(f^{14}s, {}^{2}S_{1/2}) \rightarrow Yb^+(f^{14}s, {}^{2}S_{1/2}) + Yb(4f^{14}6s^2, {}^{1}S_0) + 0 c m^{-1}$ (1) で、移行する電子のs電子の向きによらず共鳴電荷移行となり、アルカリ土類金属と同じである。 共鳴電荷移行は

共鳴電荷移行断面積の計算には、衝突しているときの原子MとイオンM⁺がつくる M_2 ⁺分子の 反対称状態および対称状態のエネルギー ε_u と ε_g の差 $\Delta(R)$ が電子の飛び移り確率に相当するの で重要である。ここでRは原子MとイオンM⁺の核間距離である。 $\Delta(R)$ の計算には、Smirnov¹¹⁾ やBardsley 等¹²⁾により行われている漸近法を用いた。電荷移行で移行する電子が s 電子の場合、 その波動関数を、

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi} u_0(r) \tag{3}$$

$$u_0(r) = q(1 + \frac{p}{r} + \dots)r^{\nu - 1}e^{-\zeta r}$$
(4)

で近似する。ここでイオン化ポテンシャルが *I* のとき、 $\zeta = (2I)^{\frac{1}{2}}$ 、 $v = 1/\zeta$ 、

 $p = -(1/2)v^2(v-1)$ 、 q は漸近規格化定数である。このとき、

$$\Delta(R) = \frac{1}{4} R \left(\frac{4}{e}\right)^{\nu} u_0^2 \left(\frac{R}{2}\right) \left[1 + \frac{\nu^2}{R} \left(\frac{3}{2}\nu - 1\right)\right]$$
(5)

となる。イッテルビウムのイオン化ポテンシャル¹⁴⁾6.25394eV よりく=0.6780、v=1.475 で漸 近規格化定数の *q*は Fischer¹³⁾が計算したハートレーーフォック波動関数に r の大きいところで 合わせるが、イッテルビウムの6 s 電子の q は r =10(原子単位)であわせ q =0.755 として、 $\Delta(R)$ を計算した。

電荷移行断面積 σ は $\Delta(R)$ から Smirnov¹⁵⁾ が与えた次の式

$$\sigma = (1/2)\pi R_0^2 - \pi^3 / (24\zeta^2)$$
(6)

を用いて簡単に求めた。ここでR₀は次の方程式

$$\left(\pi R_0 / 2\zeta\right)^{1/2} \Delta(R_0) = 0.28\nu \tag{7}$$

となる R_0 で、またvは衝突する原子、イオン間の相対速度である。

計算結果を図2に示す。反応経路は共鳴電荷移行のみなので断面積のエネルギー依存性は単調

減少である。また、衝突エネルギーが 1eV/amu である 173eV では 203Å²でアルカリ土類金属のス トロンチウムの電荷移行断面積¹⁶⁾と同程度である。

3. ルテチウムの電荷移行断面積

図3にルテチウム原子とイオンの基底状態近傍のエネルギー準位¹⁴⁾を示す。原子が4f¹⁴5d6s²、 イオンが4f¹⁴6s²である。ルテチウム原子とイオンの基底状態同士の電荷移行反応は、5d電子の 移行であり、その内側の4f¹⁴も外側の6s²も閉殻であり、反応経路は共鳴電荷移行のみである。

 $Lu(4f^{14}5d6s^2, {}^{2}D_{3/2}) + Lu^+(4f^{14}6s^2, {}^{1}S_0)$

 \rightarrow Lu⁺ (4f¹⁴6s², ¹S₀) + Lu(4f¹⁴5d6s², ²D_{3/2}) + 0 c m⁻¹ (8)

Sinha と Bardsley¹⁷⁾ はウランの電荷移行断面積を計算している。ウランの原子とイオンの電子構造は 5f⁴6d7s²、5f⁴7s²で電荷移行では 6d 電子が移行する。Sinha と Bardsley は 5f⁴の電子半径が小さく 6d 電子の移行に影響しないとして計算している。著者⁽¹¹⁾は 5f⁴(${}^{4}I_{9/2}$) と 6d_{3/2} 電子の結合による準位分裂があるので、非共鳴電荷移行も起こることを考慮して断面積を計算した。ルテチウムでは d 電子の共鳴電荷移行反応のみを考慮すればよく、Sinha と Bardsley¹⁷⁾がウランの d 電子について計算したのと同じように行った。

(3) ~ (5) 式は s 電子が移行するときの $\Delta(R)$ の計算を示したが、s 電子以外も含めた $\Delta_{lm}(R)$ の 求め方も書いておく。電荷移行する角運動量が 1 mの電子の波動関数を

$$\varphi(r) = Y_{lm}(\theta, \phi) u_0(r) \tag{9}$$

$$u_0(r) = q(1 + \frac{p}{r} + \dots)r^{\nu - 1}e^{-\zeta r}$$
(10)

で近似する。ここで $p = (1/2) \nu [l(l+1) - \nu(\nu-1)]$ である。このとき $\Delta_{lm}(R)$ は

$$\Delta_{lm}(R) = (-1)^{l+m} \frac{(2l+1)}{4(m!)} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \left(\frac{\nu}{2R}\right)^m R u_0^{-2} \left(\frac{R}{2}\right) \left(\frac{4}{e}\right)^{\nu} \\ \times \left[1 + \frac{\nu}{2R} \left(\nu(3\nu-2) + m(2\nu-3m-3) - 2(l+m+1)(l-m)\right)\right]$$
(11)

となる。ルテチウムの電荷移行では $5d_{3/2}$ の電子が移行するが、 $5d_{3/2}$ 電子のように微細構造分裂が 重要な場合分子軸方向の角運動量 Ω ごとに

$$\Delta_{j\Omega}(R) = \sum_{\mu m} \left(C_{m\mu\Omega}^{l\frac{1}{2}j} \right)^2 \Delta_{lm}(R)$$
(12)

となる。ここで $C_{m\mu\Omega}^{l^{\frac{1}{2}j}}$ はクレプシューゴルダン係数である。

ルテチウムの電荷移行時に移行する 5 d 電子の波動関数は、イオン化ポテンシャル¹⁴⁾ 5.42589eV よりζ=0.6315、ν=1.584 で Fischer¹³⁾の表の Lu の 5d 電子の数値に r =8(原子単 位) であわせ q = 0.153 とした。

電荷移行する 5d_{3/2}電子は j = 3/2 で、5d_{3/2}電子が2原子分子を作るので Ω = 3/2 と Ω = 1/2 の二つの状態がある。それぞれの $\Delta_{lm}(R)$ は(9)式より

$$\Delta_{3/2,3/2}(R) = \frac{4}{5}\Delta_{22}(R) + \frac{1}{5}\Delta_{21}(R)$$
(13)

$$\Delta_{3/2,1/2}(R) = \frac{3}{5}\Delta_{21}(R) + \frac{2}{5}\Delta_{20}(R) \tag{14}$$

となる。 $\Delta_{3/2,3/2}(R)$ 、 $\Delta_{3/2,1/2}(R)$ を図4に示す。 $\Delta_{3/2,1/2}(R)$ をは $\Delta_{21}(R)$ と $\Delta_{20}(R)$ が(8)式の $(-1)^{l+m}$ のため正負が逆になっていることによりRが大きいところでは正であるが、R = 9(原子単位)より小さくなると負になる。 $\Delta_{3/2,3/2}(R)$ 、 $\Delta_{3/2,1/2}(R)$ より、(6)式と(7)式を用いて計算した共鳴電荷

移行断面積を $\Omega = 3/2$ と $\Omega = 1/2$ それぞれについて図 5 に示す。(6) 式と(7) 式は $\Delta_{lm}(R)$ がR が増

大すると指数関数的に減少するとして成り立っている。このため衝突エネルギーが数 100eV まで しか計算できていない。 $\Omega = 3/2 \ge \Omega = 1/2$ にある確率の比は1:1なので、これらの平均値をと ればよい。反応経路が共鳴電荷移行反応のみなので電荷移行断面積のエネルギー依存性は単調減 少である。また、衝突エネルギーが 1eV/amu である 175eV で、断面積は 88Å²でイッテルビウム の断面積の 1/2 より小さい。イッテルビウムでは移行電子が 6s 電子であるのに対し、ルテチウム では移行電子が 5d 電子でその軌道半径が 6s 電子にくらべ小さいことのためである。なお、衝突 エネルギーが数 100eV 以上は(6) 式と(7) 式を用いては計算できないが、衝突径数法などを用いれ ば計算できるであろう。

4. サマリウムの電荷移行断面積

サマリウムの電子配置は原子が 4 f⁶6 s²、イオンが 4 f⁶6 s で、ネオジム、ジスプロシウム等 の多くのランタノイド原子と同じである。図6に原子とイオンの基底状態近傍のエネルギー準位 ¹⁴⁾を示す。サマリウム原子はL=3、S=3で⁷ F_{0,1,2,3,4,5,6}、サマリウムイオンはL= 3、S=7/2 で⁸ F_{1/2~13/2}とL=3、S=5/2 で⁶ F_{1/2~11/2}の二系列ある。イオンの⁸ F_{1/2~13/2}の エネルギー準位は原子の⁷ F_{0~6}とほぼ等しい。一方、イオンの⁶ F_{1/2~11/2}のエネルギー準位は原 子の⁷ F_{1~6}に1200~1300 c m⁻¹加えたものなっている。原子の4 f⁶6 s²から6 s 電子が抜けて イオンになるとき、6 s 電子の内側にある4 f⁶(⁷ F_J)が保存されると考えられる。原子の基底状 態⁷ F₀は軌道角運動量L=3とスピン角運動量S=3が逆向きでJ=0となっている。基底状態 ⁷ F₀から6 s 電子が抜けるとJ=1/2 のイオンが生成するが基底状態イオン⁸ F_{1/2} イオンのみ生 成されやすい。J=1/2 のイオンには⁶ F_{1/2} と⁸ F_{1/2}があるが、⁶ F_{1/2} は⁷ F₁から生成されると考 えられるためである。一方、Jが1以上の励起状態の原子⁷ F_Jからは⁸ F_{J+1/2} または⁶ F_{J-J/2} ができ、ネオジム等と同様である。

従って、サマリウムの原子とイオンの基底状態同士の電荷移行反応は

 $Sm(^{7}F_{0}) + Sm^{+}(^{8}F_{1/2}) \rightarrow Sm^{+}(^{8}F_{1/2}) + Sm(^{7}F_{0}) + 0 cm^{-1}$ (15)

の共鳴電荷移行反応のみ起こり、イッテルビウムやアルカリ土類金属と同様になる。これは、た またま軌道角運動量Lとスピン角運動量Sがともに3で全角運動量Jが0になったためである。

電荷移行断面積はイッテルビウムと同様に計算できる。イオン化ポテンシャル¹⁴⁾は 5.6437eV なのでく=0.644、 ν =1.552、r=10(原子単位)でFisher¹³⁾の波動関数に合わせ、q=1.85とし た。この波動関数を用い、共鳴反応経路の断面積を計算した。計算結果を図7に示す。共鳴反応 経路のみなのでイッテルビウムの場合と同様に断面積は大きくエネルギー依存性は単調減少であ る。またイッテルビウムよりイオン化ポテンシャルが小さいため、断面積の値はイッテルビウム よりも大きく、衝突エネルギーが 1eV/amu である 150eV では 224Å²である。

一方、J = 1の励起状態(292 c m⁻¹)のサマリウム原子と基底状態のイオンとの電荷移行では

$$Sm(^{7}F_{1}) + Sm^{+}(^{8}F_{1/2}) \rightarrow Sm^{+}(^{8}F_{3/2}) + Sm(^{7}F_{0}) - 34 \text{ cm}^{-1}$$
(16)
$$\rightarrow Sm^{+}(^{6}F_{1/2}) + Sm(^{7}F_{0}) - 1226 \text{ cm}^{-1}$$
(17)

の二つの反応経路がある。いずれも近共鳴であり、ネオジム等の近共鳴の電荷移行断面積計算と 同じよう 01 son¹⁵⁾が与えた一般断面積値を用いて計算した。

近共鳴電荷移行は

 $M_{A}^{+} + M_{B} \rightarrow M_{A} + M_{B}^{+} + \Delta E$ (18) で $\Delta E \vec{m} 0$ でないときである。Olson は $H_{12}(R) = (1/2) \Delta(E)$ となる R ϵR_{C} とし R $\vec{m} R_{C}$ 近傍 の

 $R_{\rm C} - \Delta R_{\rm C} \sim R_{\rm C} + \Delta R_{\rm C}$

の領域で $H_{12}(R)$ を exp(- λR)で近似して、近共鳴電荷移行断面積を数値計算で求めている。こ こで $H_{12}(R)$ は(18)式の反応系と生成系間の電子系ハミルトニアン行列要素でほぼ(1/2) $\Delta(R)$ に等しい。結果を一般速度(reduced velocity) δ^{-1}

$$\delta^{-1} = \frac{2\lambda\nu}{\pi\Delta E} \tag{19}$$

の関数として一般断面積(reduced cross section) Q^*

$$Q^* = \frac{Q}{\left(\frac{1}{2}\right)\pi R_c^2}$$
(20)

の値を出している。ここで υ は相対速度、01son の結果を用いれば相対速度 υ より δ^{-1} 、 Q^* が求まり、これに Δ (E)から求まる R_c を用いて簡便に断面積Qを得ることができる。

図2のネオジムの場合や、(16)(17)のようにいくつかの反応経路がある場合の計算法が確立されているとはいえない。ここでは、ネオジムやガドリニウムの断面積を計算したときと同じように、それぞれの反応経路の断面積を上記の(19)、(20)式を用いて求めた。これらにそれぞれの統計重率に比例した割合をかけて加えて全断面積を得た。

 Δ (R) が Δ E=34 c m⁻¹となる Rc は 24.2 (原子単位)、このとき λ =0.170、 Δ (R) が Δ E=1226 c m⁻¹となる Rc は 16.5 (原子単位)、このとき λ =0.153 であった。これらの値を用いて Δ E=34 c m⁻¹と Δ E=1226 c m⁻¹の場合の近共鳴電荷移行断面積 $\sigma_{34} \ge \sigma_{1226}$ を求めた。 J=3/2 のイオンが生成する場合と J=1/2 のイオンが生成する場合の割合は統計重率に比例して 4/(4+2)、

2/(4+2)として、加え合わせた。結果を基底状態の同士の場合とともに図7に示す。サマリウムの原子とイオンが基底状態同士であるときと比較し、原子が励起状態にあると電荷移行断面積が大きく異なる。

5. 考察

ランタノイド原子・イオン間の電荷移行反応は多くの場合、電荷移行する 6s電子の内側に閉 殻でない 4fⁿ電子等があるため、共鳴電荷移行だけでなく非共鳴電荷移行の反応経路があり、低 エネルギーでは共鳴移行反応のみ起こり、電荷移行断面積が小さい。ここでは、イッテルビウム などが共鳴電荷移行のみの反応経路しか持たないことを示し断面積を計算した。ランタノイド原 子の化学的性質が最も外側にある 6s電子が外れた状態、5d電子がある場合は5d電子も外れた 状態で決められるのに対し、電荷移行反応は 6s電子の移行であり、6s電子と内側にある 4f電 子との相互作用が 4f電子の数により変わってくること、また 5d電子の有無により変わってくる ため、ランタノイド元素の間でも電荷移行反応に違いがある。

これまで、ランタノイドの電荷移行断面積の測定を衝突エネルギーが 100~2000 e Vでガドリ ニウム、ネオジム、ジスプロシム、セリウムについて行ってきた。電荷移行断面積を計算したガ ドリニウム、ネオジム、ジスプロシウムについてはいずれも測定値は計算値の約1.5 倍であった。 共鳴電荷移行のみ起きるイッテルビウムは断面積が大きくまたそのエネルギー依存性もアルカリ 金属やアルカリ土類金属と同じなので衝突エネルギーの増大で単調に減少するはずである。Y b の電荷移行断面積の測定はまだなされていないが、測定を行えばこれまでの計算手法の確証、実 験手法の確認にもなると思われる。サマリウムの基底状態同士の原子・イオン間の電荷移行断面 積が大きいこと示した。基底状態のイオンビームを作ることはレーザーによる共鳴イオン化で容 易であるが、サマリウム原子は図6のようにエネルギーの低い励起状態が多いので、基底状態の 原子ビームをつくることは難しい。このためサマリウムの基底状態同士の原子・イオン間電荷移 行の実験を行うのは難しいであろう。

また、セリウムは原子が4f5ds²、イオンが4f5d²である。セリウムの電荷移行は単純に一電子 が移行するだけでは進行しない。セリウムの電荷移行断面積を衝突エネルギー100~2000 e Vで測 定し、約90Å²と非常に小さい値が得られたのは単純な一電子移行ではないためと考えられる。 測定値と比較するためには、2電子移行または配置間相互作用を考慮した原子波動関数を考慮し た1電子移行で計算する必要があると思われる。

6. まとめ

ランタノイド元素のうち、イッテルビウム、ルテチウム、サマリウムの対称電荷移行断面積を 計算した。ランタノイド原子・イオン間の電荷移行反応は多くの場合、共鳴電荷移行だけでなく 非共鳴電荷移行の反応経路があり、低エネルギーでは共鳴移行反応のみ起こり、電荷移行断面積 が小さい。ここで取り上げたイッテルビウム、ルテチウム、サマリウムは多くの他のランタノイ ド元素とは異なり、共鳴電荷移行のみが進行する。このため、電荷移行断面積のエネルギー依存 性は単調減少である。また、イッテルビウム、サマリウムの断面積は衝突エネルギーが 1eV/amu で、それぞれ、203Å²、224Å²で、アルカリ土類金属のバリウムの電荷移行断面積と同程度で、 ジスプロシウム等の多くのランタノイド元素の電荷移行断面積より大きい。一方、ルテチウムではd電子が移行するため電荷移行断面積は衝突エネルギーが 1eV/amu で 65Å²と小さい。

本報告について貴重な議論をしていただいた北里大学医学部の小池文博准教授に感謝いたします。

参考文献

- (1) A. von Engel, 山本賢三監訳: "プラズマ工学の基礎"(オーム社,東京, 1985).
- (2)小倉浩一、有沢孝、柴田猛順: 真空 35, 301(1992).
- (3)K.Ogura and T.Shibata: 質量分析 41, 37(1993).
- (4)小倉浩一、柴田猛順: JAERI-Conf 95-022, 107(1995).
- (5) 足立肇、田村浩司、岡崎哲治、柴田猛順: JAERI-Research 98-030 (1998).
- (6) K. Tamura, H. Adachi, and T. Shibata: Jpn. J. Appl. Phys. 38, 2973(1999).
- (7)柴田猛順、小倉浩一: JAERI-Research 94-025 (1994).
- (8) T. Shibata and K. Ogura : J. Phys. Soc. Jpn. 64, 3136(1995).
- (9)柴田猛順、小倉浩一: JAERI-Research 95-025(1995).
- (10) 足立肇、田村浩司、岡崎哲治、小倉浩一、大場弘則、柴田猛順: JAERI-Research 99-029 (1999).
- (11)B.M.Smirnov:Soviet Phys. JETP 20, 345(1965).
- (12) J. N. Bardsley, T. Holstein, B. R. Junker and S. Sinha: Phys. Rev. A11, 1911(1975).
- (13)C.F.Fischer: Atomic Data and Nuclear Data Tables 12, 87(1973).
- (14) W. C. Martin, R. Zalubas and L. Hagan: "Atomic Energy Levels-The Rare-Earth Elements" U.S. Department of Commerce National Technical information Service PB-282 067(1978).
- (15) B.M. Smirnov: Soviet Phys. JETP 19, 692(1964).
- (16) G. S. Panev, A. N, Zavilopulo, I. P. Zapesochnyi and O. B. Shpenik: Sov. Phys. JETP 40, 23(1975).
- (17)S.Sinha and J.N.Bardsley: Phys.Rev. A14, 104(1976).
- (18) R. E. Olson : Phys. Rev. A6, 1822 (1972).

JAEA-Research 2008-076



図1 ネオジムの電荷移行反応

(a) (b) 二つの反応経路があり、(a) は共鳴反応経路であり(b) は非共鳴電荷移行反応経路である。



図2 イッテルビウムの電荷移行断面積



図3 ルテチウムの原子とイオンの基底状態近傍のエネルギー準位図











図6 サマリウムの原子とイオンの基底状態近傍のエネルギー準位図



図7 サマリウムの電荷移行断面積

付録 ジスプロシウムの電荷移行断面積

ランタノイド元素の多くが原子は4fⁿ6s²、イオンは4fⁿ6sの電子配置を持ち、対称電荷移行 では6s電子が移行する。電荷移行する6s電子の内側に閉殻でない4fⁿ電子があるため、共鳴電 荷移行だけでなく非共鳴電荷移行の反応経路がある。本報告では非共鳴反応経路がないイッテル ビウム、ルテチウム、サマリウムの対称電荷移行断面積の計算結果を示したが、他の多くのラン タノイドと比較のため、本付録ではジスプロシウムの対称電荷移行断面積の計算結果を示す。こ の計算結果はすでにジスプロシウムの電荷移行断面積測定結果とともにすでに簡単に報告^{5,6)}し ているが、未報告の計算方法、用いた波動関数なども含めて本付録で述べる。

付録図1にジスプロシウムの原子とイオンの基底状態近傍のエネルギー準位¹⁴⁾を示す。基底状態の原子から 6s 電子が基底準位のイオンに移行すると、原子は基底状態の Dy⁺(f¹⁰(⁵I₈)6s, J= 17/2)または励起エネルギーが 828 c m⁻¹の Dy⁺(f¹⁰(⁵I₈)6s, J=15/2)になる。このため図1のネオジムと同様に、

 $Dy(4f^{10}6s^2, {}^{5}I_8) + Dy^+(f^{10}({}^{5}I_8)6s, J=17/2)$

→ $Dy^+(f^{10}({}^{4}I_{q/2})6s, J=17/2) + Dy(4f^{10}6s^2, {}^{5}I_8) + 0 \text{ cm}^{-1}$ (付 1)

 $Dy^+(f^{10}({}^{4}I_{9/2})6s, J=15/2) + Dy(4f^{10}6s^2, {}^{5}I_8) - 828 \text{ cm}^{-1}$ (\pounds 2)

の二つの反応経路が考えられる。

ジスプロシウムの 6s 波動関数はイオン化ポテンシャル¹⁴⁾5.9389eV よりζ=0.661、v=1.514 で、Fisher¹³⁾の波動関数に合わせ、q=2.11 とした。(5)式によりΔ(R)を求め、これを用いて (6)、(7)式により共鳴のときの電荷移行断面積 σ_{res} を計算した。また、非共鳴のときの電荷移行 断面積は 01son の求め方に従って計算した。ここで、ΔE=828 c m⁻¹=3.77×10⁻³ でV_{AB}(R) = (1/2) ΔE となる R より R_oを求めると R_o=17(原子単位)となる。この付近の V_{AB}(R)を exp(- λ R) で近似すると λ =0.37 となる。これらの値を用いて(19)式、(20)式より非共鳴の電荷移行断面積 σ_{828} を計算した。共鳴反応経路と非共鳴反応経路をとる割合は統計重率に比例させ、共鳴反応経 路が 18/(18+16)、非共鳴反応経路が 16/(18+16)として加え合わせて全体の電荷移行断面積とし た。付録図 2 に計算結果を示す。衝突エネルギーが 1eV/amu で、断面積は 112Å²で、イッテルビ ウムやサマリウムと比較し非常に小さい。

付録図2には、衝突エネルギー100~2000eV での測定結果 ^{5,6)}も載せてある。測定値は 100~2000eV の全領域で 182±14Å²で計算値の 1.5~1.6 倍でばらつきも大きいが、衝突エネルギーが増大しても減少していない。これは数 100eV 以上では共鳴の(付 1)の反応だけでなく非共鳴の(付 2)の反応も起こっているためと考えられる。



付録図1 ジスプロシウムの原子とイオンの基底状態近傍のエネルギー準位図



付録図2 ジスプロシウムの電荷移行断面積

This is a blank page.

表1. SI 基本単位					
甘木昌	SI 基本]	単位			
本平里	名称	記号			
長さ	メートル	m			
質 量	キログラム	kg			
時 間	秒	S			
電 流	アンペア	А			
熱力学温度	ケルビン	Κ			
物質量	モル	mol			
光 度	カンデラ	cd			

如去早	SI 基本単位			
和1.12.里	名称	記号		
面積	平方メートル	m ²		
体積	立法メートル	m ³		
速 さ , 速 度	メートル毎秒	m/s		
加 速 度	メートル毎秒毎秒	m/s^2		
波 数	毎 メ ー ト ル	m-1		
密度(質量密度)	キログラム毎立法メートル	kg/m^3		
質量体積(比体積)	立法メートル毎キログラム	m ³ /kg		
電流密度	アンペア毎平方メートル	A/m^2		
磁界の強さ	アンペア毎メートル	A/m		
(物質量の) 濃度	モル毎立方メートル	$mo1/m^3$		
輝 度	カンデラ毎平方メートル	cd/m^2		
屈 折 率	(数の) 1	1		

表5. SI 接頭語

乗数	接頭語	接頭語 記号 乗数		接頭語	記号			
10^{24}	Э 9	Y	10^{-1}	デシ	d			
10^{21}	ゼタ	Z	10^{-2}	センチ	с			
10^{18}	エクサ	E	10^{-3}	ミリ	m			
10^{15}	ペタ	Р	10^{-6}	マイクロ	μ			
10^{12}	テラ	Т	10^{-9}	ナノ	n			
10^{9}	ギガ	G	10^{-12}	ピョ	р			
10^{6}	メガ	М	10^{-15}	フェムト	f			
10^{3}	+ 1	k	10^{-18}	アト	а			
10^{2}	ヘクト	h	10^{-21}	ゼプト	z			
10 ¹	デ カ	da	10^{-24}	ヨクト	у			

表3. 固有の名称とその独自の記号で表されるSI組立単位 SI 組立畄位

	51 和立中位				
組立量	夕敌	記早	他のSI単位による	SI基本単位による	
	2日 1小	記与	表し方	表し方	
平 面 角	ラジアン ^(a)	rad		$\mathbf{m} \cdot \mathbf{m}^{-1} = 1^{(b)}$	
立 体 角	ステラジアン ^(a)	$\mathrm{sr}^{(\mathrm{c})}$		$m^2 \cdot m^{-2} = 1^{(b)}$	
周 波 数	、ヘルツ	Hz		s ⁻¹	
力	ニュートン	Ν		$m \cdot kg \cdot s^{-2}$	
压力, 応力	パスカル	Pa	N/m^2	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$	
エネルギー,仕事,熱量	ジュール	J	N•m	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$	
工率,放射束	ワット	W	J/s	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$	
電荷,電気量	フーロン	С		s•A	
電位差(電圧),起電力	ボルト	V	W/A	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$	
静電容量	ファラド	F	C/V	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$	
電気抵抗	オーム	Ω	V/A	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$	
コンダクタンス	ジーメンス	S	A/V	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$	
磁東	ウェーバ	Wb	V•s	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$	
磁束密度	テスラ	Т	Wb/m^2	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$	
インダクタンス	ヘンリー	Н	Wb/A	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$	
セルシウス温度	セルシウス度 ^(d)	°C		K	
光東	ルーメン	1m	$cd \cdot sr^{(c)}$	$m^2 \cdot m^{-2} \cdot cd = cd$	
照度	ルクス	1x	1m/m^2	$m^2 \cdot m^{-4} \cdot cd = m^{-2} \cdot cd$	
(放射性核種の)放射能	ベクレル	Bq		s ⁻¹	
吸収線量, 質量エネル	HIZ	Cu	T/kg	22	
ギー分与, カーマ		Gy	J/ Kg	m•s	
線量当量,周辺線量当					
量,方向性線量当量,個	シーベルト	Sv	J/kg	m ² • s ⁻²	
人禄量当量, 組織線量当					

(a) ラジアン及びステラジアンの使用は、同じ次元であっても異なった性質をもった量を区別するときの組立単位の表し方として利点がある。組立単位を形作るときのいくつかの用例は表4に示されている。
 (b) 実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号"1"は明示されない。
 (c) 測光学では、ステラジアンの名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している。
 (d) この単位は、例としてミリセルシウス度m℃のようにSI接頭語を伴って用いても良い。

表4. 単位の中に固有の名称とその独自の記号を含むSI組立単位の例

	SI 組立単位			
組工重	名称	記号	SI 基本単位による表し方	
粘度	モパスカル秒	Pa•s	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-1}$	
力のモーメント	ニュートンメートル	N•m	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$	
表 面 張 九	リニュートン毎メートル	N/m	kg • s ⁻²	
角 速 度	ミラジアン毎秒	rad/s	$m \cdot m^{-1} \cdot s^{-1} = s^{-1}$	
角 加 速 度	ミラジアン毎平方秒	rad/s^2	$m \cdot m^{-1} \cdot s^{-2} = s^{-2}$	
熱流密度,放射照度	E ワット毎平方メートル	W/m^2	kg • s ⁻³	
熱容量、エントロピー	ジュール毎ケルビン	J/K	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot K^{-1}$	
質量熱容量(比熱容量),	ジュール毎キログラム 毎ケルビン	J/(kg•K)	$m^2 \cdot s^{-2} \cdot K^{-1}$	
質量エネルギー (比エネルギー)	ジュール毎キログラム	J/kg	$\mathbf{m}^2 \cdot \mathbf{s}^{-2} \cdot \mathbf{K}^{-1}$	
熱伝導率	^E ワット毎メートル毎ケ ルビン	₩/(m•K)	$\mathbf{m} \cdot \mathbf{kg} \cdot \mathbf{s}^{-3} \cdot \mathbf{K}^{-1}$	
体積エネルギー	ジュール毎立方メート ル	J/m^3	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$	
電界の強さ	ボルト毎メートル	V/m	$\mathbf{m} \cdot \mathbf{kg} \cdot \mathbf{s}^{-3} \cdot \mathbf{A}^{-1}$	
体 積 電 荷	クーロン毎立方メート ル	C/m^3	$m^{-3} \cdot s \cdot A$	
電気変位	クーロン毎平方メート ル	C/m^2	$m^{-2} \cdot s \cdot A$	
誘 電 幸	ミファラド毎メートル	F/m	$m^{-3} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$	
透磁率	国ヘンリー毎メートル	H/m	$\mathbf{m} \cdot \mathbf{kg} \cdot \mathbf{s}^{-2} \cdot \mathbf{A}^{-2}$	
モルエネルギー	・ジュール毎モル	J/mol	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot mol^{-1}$	
モルエントロピー, モル 熱 容量	ジュール毎モル毎ケル ビン	$J/(mo1 \cdot K)$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot K^{-1} \cdot mo1^{-1}$	
照射線量(X線及びv線)	クーロン毎キログラム	C/kg	$kg^{-1} \cdot s \cdot A$	
吸収線量率	ミグレイ 毎 秒	Gy/s	m ² · s ⁻³	
放射强度	モワット毎ステラジアン	W/sr	$m^4 \cdot m^{-2} \cdot kg \cdot s^{-3} = m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$	
放射輝 度	ワット毎平方メートル	W/(m ² · sr)	$\mathbf{m}^2 \cdot \mathbf{m}^{-2} \cdot \mathbf{kg} \cdot \mathbf{s}^{-3} = \mathbf{kg} \cdot \mathbf{s}^{-3}$	

表6. 国際単位系と併用されるが国際単位系に属さない単位

名称	記号	SI 単位による値
分	min	1 min=60s
時	h	1h =60 min=3600 s
日	d	1 d=24 h=86400 s
度	0	$1^{\circ} = (\pi / 180)$ rad
分	,	1' = $(1/60)^{\circ}$ = $(\pi/10800)$ rad
秒	"	1" = $(1/60)$ ' = $(\pi/648000)$ rad
リットル	1, L	$11=1 \text{ dm}^3=10^{-3}\text{m}^3$
トン	t	1t=10 ³ kg
ネーパ	Np	1Np=1
ベル	В	1B=(1/2)1n10(Np)

表7.国際単位系と併用されこれに属さない単位で SI単位で表される数値が実験的に得られるもの							
名称	記号	SI 単位であらわされる数値					
電子ボルト	eV	$1 \text{eV}=1.60217733(49) \times 10^{-19} \text{J}$					
統一原子質量単位	u	1u=1.6605402(10)×10 ⁻²⁷ kg					
天 文 単 位	ua	1ua=1.49597870691(30)×10 ¹¹ m					

表8. 国際単位系に属さないが国際単位系と 併用されるその他の単位

	併用されるその他の単位						
	名称		記号	SI 単位であらわされる数値			
海		里		1 海里=1852m			
1	ツ	F		1 ノット=1 海里毎時=(1852/3600)m/s			
P		ル	а	$1 \text{ a=} 1 \text{ dam}^2 = 10^2 \text{m}^2$			
へ ク	ター	ル	ha	1 ha=1 hm ² =10 ⁴ m ²			
バ	_	ル	bar	1 bar=0.1MPa=100kPa=1000hPa=10 ⁵ Pa			
オンク	「ストロ・	- 4	Å	1 Å=0. 1nm=10 ⁻¹⁰ m			
バ	-	\sim	b	$1 \text{ b}=100 \text{ fm}^2=10^{-28} \text{m}^2$			

表9 固有の名称を含むCGS組立単位

	X J. 固有 97 和你老 自己 665 起立 平臣							
	名称		記号	SI 単位であらわされる数値				
工	N	グ	erg	1 erg=10 ⁻⁷ J				
ダ	イ	\sim	dyn	1 dyn=10 ⁻⁵ N				
ポ	ア	ズ	Р	1 P=1 dyn⋅s/cm²=0.1Pa・s				
ス	トーク	ス	St	1 St =1cm ² /s=10 ⁻⁴ m ² /s				
ガ	ウ	ス	G	1 G 110 ⁻⁴ T				
T.	ルステッ	F	0e	1 Oe 🛔 (1000/4π) A/m				
7	クスウェ	ル	Mx	1 Mx #10 ⁻⁸ Wb				
ス	チル	ブ	sb	$1 \text{ sb} = 1 \text{ cd/cm}^2 = 10^4 \text{ cd/m}^2$				
朩		ŀ	ph	$1 \text{ ph}=10^4 1 \text{ x}$				
ガ		ル	Gal	$1 \text{ Gal} = 1 \text{ cm/s}^2 = 10^{-2} \text{m/s}^2$				

表10. 国際単位に属さないその他の単位の例					
名称				記号	SI 単位であらわされる数値
キ	ユ	IJ	ĺ	Ci	1 Ci=3.7×10 ¹⁰ Bq
\mathcal{V}	\sim	トク	゛ン	R	$1 \text{ R} = 2.58 \times 10^{-4} \text{C/kg}$
ラ			ド	rad	1 rad=1cGy=10 ⁻² Gy
\mathcal{V}			L	rem	1 rem=1 cSv=10 ⁻² Sv
Х	線	単	位		1X unit=1.002×10 ⁻⁴ nm
ガ		ン	7	γ	$1 \gamma = 1 nT = 10^{-9}T$
ジ	ャン	(ス:	キー	Jy	$1 \text{ Jy}=10^{-26} \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{Hz}^{-1}$
フ	л.	ル	5		1 fermi=1 fm=10 ⁻¹⁵ m
メートル系カラット					1 metric carat = 200 mg = 2×10^{-4} kg
ŀ			ル	Torr	1 Torr = (101 325/760) Pa
標	準	大 気	〔圧	atm	1 atm = 101 325 Pa
力	口	リ	-	cal	
Ξ	ク		ン	u	$1 \text{ u} = 1 \text{ um} = 10^{-6} \text{ m}$

この印刷物は再生紙を使用しています